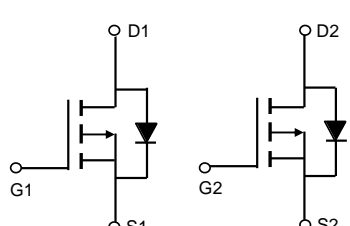
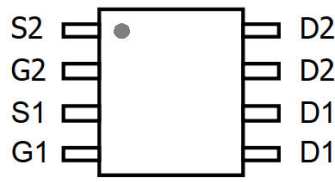
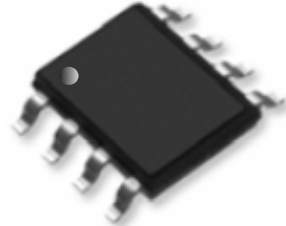


FH4953C
-20V Dual P-Channel Enhancement Mode MOSFET

<p>特点</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 先进的沟道工艺技术 ◆ 高密度超低电阻设计 ◆ 改良的成形工艺 	<p>特征</p> <p>VDS= -20V RDS(ON), Vgs@-10V, Ids@-4.5A = 7 0mΩ @TYP RDS(ON), Vgs@-4.5V, Ids@-4.2A = 9 0mΩ @TYP</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Schematic diagram</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Marking and Pin Assignment</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>SO-8 top view</p> </div> </div>	

最大额定值和热特性(TA = 25℃, 除非另有说明。)

参数	符号	值	单位
漏源电压	V _{DS}	-20	V
栅源电压	V _{GS}	±12	
漏极电流	I _D	-4.5	A
漏极脉冲电流	I _{DM}	-18	
工作结温和存储温度范围	T _J , T _{stg}	-50 to 150	℃

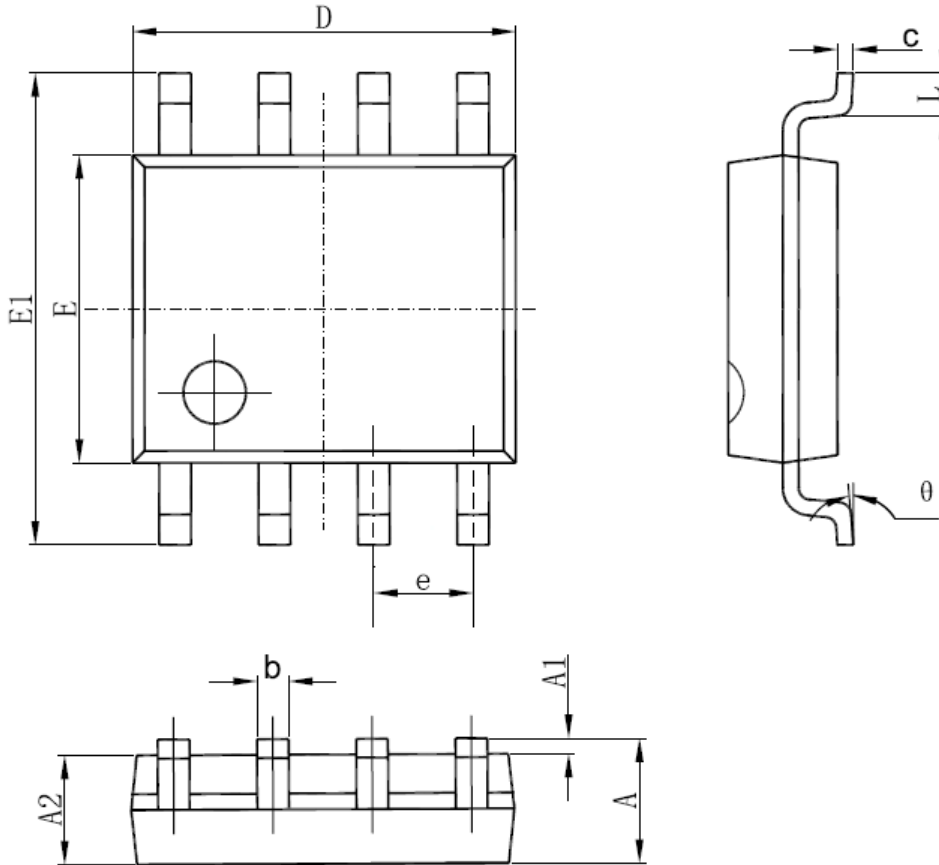
注：重复性极限值：脉冲宽度由最高结温限制。

电特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
静电						
漏源击穿电压	B_{VDSS}	$V_{GS} = 0V, I_D = -250\mu A$	-20	--	--	V
漏源电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -10V, I_D = -4.5A$	--	70	90	mΩ
	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -4.5V, I_D = -4.2A$	--	90	110	
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu A$	-1	-1.4	-3	V
栅源短路时漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS} = -24V, V_{GS} = 0V$	--	--	-1	μA
漏极短路时截止栅电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$	--	--	±100	μA
跨导	G_{fs}	$V_{DS} = -10V, I_D = -4.5A$	--	10	--	S
漏源二极管						
二极管最大正向电流	I_S	--	--	--	2.6	A
二极管正向电压	V_{SD}	$I_S = -2.6A, V_{GS} = 0V$	--	--	-1.3	V

注：脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$

Package Information : SO-8



SYMBOL	MM		INCH		SYMBOL	MM		INCH	
	MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.350	1.750	0.053	0.069	E	3.800	4.000	0.150	0.157
A1	0.100	0.250	0.004	0.010	E1	5.800	6.200	0.228	0.244
A2	1.350	1.550	0.053	0.061	e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
b	0.330	0.510	0.013	0.020	L	0.400	1.270	0.016	0.050
c	0.170	0.250	0.006	0.010	θ	0°	8°	0°	8°
D	4.700	5.100	0.185	0.200					